Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0212U009005

Державний реєстраційний номер: 0111U001226

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-12-2012

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 2

Назва етапу: Розробка концепції створення мікро- та наноелектронних перетворювачів на основі ниток Si та Si-Ge та КНІ-структур

Початок етапу: 04.2011

Закінчення етапу: 12.2012

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (032) 2375089

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 229.686

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка наукових основ і технологічних методів створення перетворювачів на базі мікро- і наноструктур кремнію для інформаційних систем

Назва роботи англійською:

Elaboration of scientific base and processing methods of converters on micro- and nanostructures of silicon for infocommunication systems

Реферат українською:

Виявлено і вивчено механізми впливу фізичних та технологічних чинників на умови формування мікро- та наноструктур кремнію та розвинено наукові основи і технологічні методи щодо створення перетворювачів на їх основі для інформаційних систем

Реферат англійською:

Identify and study mechanisms influence of physical and technological factors on the conditions of formation of micro-and nanostructures of silicon and developed scientific principles and technological methods for creating converters based on them for information systems5481

Індекс УДК: 681.121./123; 532.57, 531.787

Коди тематичних рубрик: 59.37.33

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Дружинін Анатолій Олександрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Механізми впливу фізичних та технологічних чинників на умови формування мікро- та наноструктур кремнію та наукові основи і технологічні методи щодо створення перетворювачів на їх основі для інформаційних систем

Назва НТП англійською: Mechanisms influence of physical and technological factors on the conditions of formation of micro-and nanostructures of silicon and developed scientific principles and technological methods for creating converters based on them for information systems

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: сенсори фізичних величин

Галузь застосування: 32.10.0 Виробництво напівпровідникових приладів

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розширені фізичні уявлення про вплив чинників таких як деформація, сильні магнітні поля і температура на властивості структур на основі мікро- і нанокристалів Si, Si1-xGex, легованих домішками до концентрацій поблизу переходу метал-діелектрик,що дало можливість створити високочутливі сенсори на основі таких нанокристалів, зокрема магнітного поля і температури

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2-3 роки

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Галузь сенсорної електроніки

Перспективні ринки: Україна, СНД

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 300

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 500

Очікуваний термін окупності (років): 3

Додаткова інформація: за договорами

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Піх Зорян Григорович
д. х. н.

Перелік осіб-виконавців

Бережанський Є.І.

Вуйцик А.М.

Гарасим І.Д.

Гвоздик Р.

Дружинін А.О.

Когут Ю.Р.

Корецький Р.М.

Кузишин Н.І.

Кутраков О.П.

Лях-Кагуй Н.С.

Нічкало С.І.

Островський І.П.

Перетятко В.

Хамуляк В.

Ховерко .Ю.М.

Яцухненко С.Ю.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

